

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные электрические параметры при поставке, эксплуатации и хранении

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Н о р м а		Температура, К
	не менее	не более	
Входное напряжение высокого уровня, V ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	2,55	-	298
Входное напряжение низкого уровня, V ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	2,4	-	343, 263
Ток потребления в режиме "Считывание", mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	-	0,4	343, 263
Ток потребления в режиме "Запись", mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	-	85	298
Ток потребления в режиме "Тренировка", mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	-	100	343, 263
Ток потребления по выводу Q_9 в режиме "Считывание", mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$)	-	20	298
Ток утечки на входах адресных, $CS/\overline{RD}$, mA ($U_{cc} = 0 \text{ V}$, $U_{inH} = 0 \text{ V}$, $U_{inL} = 0 \text{ V}$, $U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{cc} = 5,25 \text{ V}$)	-	25	343, 263
Ток утечки на выходах в режиме "Неактивен" $\overline{RD}$, mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 5,25 \text{ V}$)	-	9	298
Ток утечки на выходах в режиме "Неактивен" $\overline{RD}$, mA ($U_{cc} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inH} = 5,25 \text{ V}$, $U_{inL} = 0,6 \text{ V}$, $U_{cc} = 2,2 \text{ V}$, $U_{cc} = 5,25 \text{ V}$)	-	10	343, 263
Время выбора адреса, ns ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,4 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$, $t_{cr} = 2,4 \text{ ns}$, $t_{d, t, f} \leq 40 \text{ ns}$, $C_L \neq 100 \text{ pF}$)	-	5	298
Время выбора адреса, ns ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,4 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$, $t_{cr} = 2,4 \text{ ns}$, $t_{d, t, f} \leq 40 \text{ ns}$, $C_L \neq 100 \text{ pF}$)	-	10	343
Время выбора адреса, ns ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,4 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$, $t_{cr} = 2,4 \text{ ns}$, $t_{d, t, f} \leq 40 \text{ ns}$, $C_L \neq 100 \text{ pF}$)	-	400	298
Время выбора адреса, ns ($U_{cc} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inH} = 4,75 \text{ V}$, $U_{inL} = 2,4 \text{ V}$, $U_{cc} = 0,6 \text{ V}$, $t_{cr} = 2,4 \text{ ns}$, $t_{d, t, f} \leq 40 \text{ ns}$, $C_L \neq 100 \text{ pF}$)	-	450	343, 263
Количество циклов перепрограммирования	-	100	298

3.2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Напряжение питания, V	-	5,25
Входное напряжение низкого уровня, V	-0,1	0,4
Входное напряжение высокого уровня, V	2,4	5,25
Напряжение сигнала программирования на выводе Q_9 , V	24	26
Выходной ток низкого уровня, mA	-	1,6
Время спада, ns	-	100
Время нарастания, ns	-	100
Емкость нагрузки, pF	-	100

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. В процессе испытаний и эксплуатации необходимо исключить попадание на микросхему ультрафиолетовых лучей и потоков соленого или лимоннокислого света, для чего экран микросхемы закрывают лентой.
- 4.2. Установка микросхем на печатную плату рекомендуется в приспособлении, удобном для ее извлечения для последующего перепрограммирования. Допускается программирование микросхем в составе платы.
- 4.3. Допускается наличие статического потенциала не более 30 В.
- 4.4. Извлечение микросхем из контактного приспособления необходимо производить при отсутствии напряжений на ее выводах.
- 4.5. Допускается подключать к выходам микросхем один из микросхем серии TTL, а питание тех и других осуществлять от одного источника питания.
- 4.6. Допускается обесценивание микросхем по входам для увеличения разрядности и по выходам для увеличения емкости.
- 4.7. Для записи информации осуществляется параллельная запись в бит информации по адресу из выводов при подаче импульсов $\overline{RD}$. После циклового старания все ячейки памяти находятся в состоянии высокого уровня напряжения ($U_{inH} > 2,4 \text{ V}$). В микросхему записываются только низкие уровни, при этом высокие и низкие уровни напряжения высокой информативности могут быть представлены в 8 системах кодирования бита. Чтобы избежать состояния низкого уровня на состоянии высокого уровня напряжения, микросхему программируют старание сигналом 16-лучем. Допускается контроль записанной информации производить после записи всех ячеек.
- 4.8. Не допускается электрический контакт корпуса микросхем (вывод 12) с землей, имеющим потенциал, отличный от GND .

5. ХРАНЕНИЕ

Микросхемы следует хранить в герметизированных (или упакованных в антистатический) упаковках при температуре от 274 до 313 К. Относительная влажность воздуха для хранения 20-80% при температуре 23-31 К; при более низких температурах относительная влажность ниже.

6. СИСТЕМА О ПРИЕМЕ

Микросхемы K573105 проверяются отделом технического контроля и признаются годными для эксплуатации.



КВАЗЕР ЕООД

София 02/98 35 700
Плевен 064/ 801 979

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 626 664
Пловдив 032/ 675 134